

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年5月25日(25.05.2023)



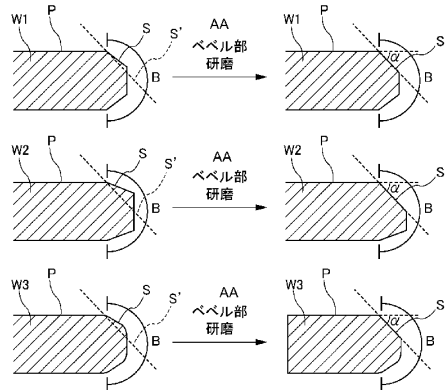
(10) 国際公開番号

WO 2023/090052 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/10 (2012.01) *B24B 49/02* (2006.01)
B24B 9/00 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
B24B 21/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/039327
- (22) 国際出願日: 2022年10月21日(21.10.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-187594 2021年11月18日(18.11.2021) JP
- (71) 出願人: 株式会社荏原製作所 (**EBARA CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 中西 正行 (**NAKANISHI, Masayuki**);
〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号
株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 廣澤 哲也, 外 (**HIROSAWA, Tetsuya et al.**); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 8 号 GOWA 西新宿 4 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,

(54) **Title:** SUBSTRATE PROCESSING METHOD AND SUBSTRATE PROCESSING DEVICE

(54) 発明の名称: 基板処理方法および基板処理装置



AA Polish bevel section

(57) **Abstract:** The present invention pertains to a substrate processing device for processing substrates such as a wafer, and particularly to a substrate processing method and a substrate processing device which polish a bevel section of a substrate and perform a CMP process on a flat surface section of the substrate. The substrate processing method involves: polishing, with a polishing tool, bevel sections (B) of a plurality of substrates (W) so that the tilt angles (α) of tilt surfaces (S) of bevel sections (B) of the plurality of substrates (W) are equal to each other; and performing a CMP process on planar sections (P) of the plurality of substrates (W) in which the bevel sections (B) have been polished.

(57) 要約: 本発明は、ウェーハなどの基板を処理する基板処理装置に関し、特に基板のベベル部の研磨、および基板の平面部のCMP処理を行う基板処理方法および基板処理装置に関するものである。基板処理方法は、複数の基板(W)のベベル部(B)の傾斜面(S)の傾斜角度(α)が同じとなるように、複数の基板(W)のベベル部(B)を研磨具で研磨し、ベベル部(B)が研磨された複数の基板(W)の平面部(P)をCMP処理する。

[続葉有]



WO 2023/090052 A1

SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))